

850V–110A N-CHANNEL MOSFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

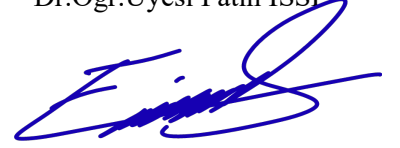
1. Mosfet **N-Kanal** olmalıdır.
2. Drain-Source gerilimi en az **850V** olmalıdır.
3. Drain akımı en az **110A** olmalıdır.
4. Drain-Source direnci **33m Ω** veya daha düşük olmalıdır.
5. Mosfet paketi **SOT-227** kılıfa sahip olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ISSI

LAUNCHPAD TMS320F2837XD/2837XS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az **2 adet 32 Bit İşlemci(CPU)**'ye sahip olmalıdır.
2. En az **200Mhz** çalışma frekansına sahip olmalıdır.
3. En az **4 adet Seri Haberleşme(UART)** kanalına sahip olmalıdır.
4. En az **24 kanal Darbe Genlik Modülasyonu(PWM)** kanalına sahip olmalıdır.
5. En az **6 adet Gelişmiş Yakalama(eCAP)** modülüne sahip olmalıdır.
6. Belirtilen özelliklerdeki MCU, bağlantı pinleri bulunan bir **geliştirme kartı** üzerinde yer almalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ISSI



**151X200X85 ALÜMİNYUM ÇOK KANALLI MOSFET SOĞUTUCU TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Soğutucu ölçüleri **200cm** uzunluk, **85cm** genişlik ve **15cm** yüksekliğe sahip olmalıdır.
2. Soğutucu **çok kanallı** olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Fatih İSSİ

